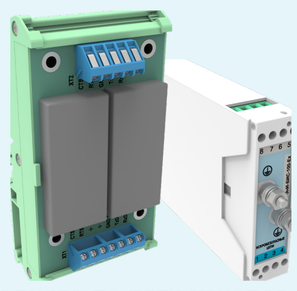
ГРУППА ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

ИТеК ББМВ

Энергия – Источник

БАРЬЕРЫ ИСКРОЗАЩИТЫ • ЭнИ-БИС-Ex • ПАССИВНЫЕ (ШУНТ-ДИОДНЫЕ)

СЕРИЯ	ЭнИ-БИС-100-Ex			ЭнИ-БИС-150-Ex			ЭнИ-БИС-1000-Ex		
									
ТИП ВХОДНОГО/ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ИЛИ УСТРОЙСТВА	• от одного до пяти каналов; • установка на DIN-рейку, на стену или в щит			• один канал; • установка на DIN-рейку или на стену; • замена импортных аналогов			• один или два канала; • установка на DIN-рейку; • замена импортных аналогов; • компактный корпус 12,5 мм		
Сигнал NAMUR EN 60947				**ЭнИ-БИС-153-Ex-AC**		• U_0=15,5/15,5 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB	**ЭнИ-БИС-1153-Ex-AC-s**	• дополнительные стабилитроны между ветвями барьера;	• U_0=15,5/15,5 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
Входной токовый сигнал	**ЭнИ-БИС-108-Ex**		• U_0=25,2 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB				**ЭнИ-БИС-1008-Ex-AC**		• U_0=26,4/26,4 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
				ЭнИ-БИС-151-Ex-DC(+)		• U_0=28,0/10,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB	**ЭнИ-БИС-1151-Ex-DC(+)**		• U_0=28,0/10,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
	ЭнИ-БИС-110-Ex		• U_0=25,2 В; • [Ex ib Gb] IIC/IIB				**ЭнИ-БИС-1010-Ex-DC(+)**		• U_0=25,8/25,8 В; • [Ex ib Gb] IIC/IIB
				ЭнИ-БИС-151-Ex-DC(+)-R250	• в составе резистор 250 Ом;	• U_0=28,0/10,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB	**ЭнИ-БИС-1151-Ex-DC(+)-R250**	• в составе резистор 250 Ом;	• U_0=28,0/10,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
	ЭнИ-БИС-112-Ex	• 5 каналов;	• U_0=29,0 В; • [Ex ia Ga] IIB	**ЭнИ-БИС-157-Ex-DC(+)-d-P**	• в составе одного полюса диод; • повышенная мощность;	• U_0=28,0/28,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB	**ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-d-P**	• в составе одного полюса диод; • повышенная мощность;	• U_0=28,0/28,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
	ЭнИ-БИС-114-Ex	• 5 каналов;	• U_0=29,0 В; • [Ex ib Gb] IIB						
	ЭнИ-БИС-117-Ex		• U_0=27,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB						
							ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-d-f	• в составе одного полюса диод; • сменные предохранители;	• U_0=28,0/28,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
							ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-d-P-f	• в составе одного полюса диод; • повышенная мощность; • сменные предохранители;	• U_0=28,0/28,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
Выходной токовый сигнал				**ЭнИ-БИС-157-Ex-DC(+)**		• U_0=28,0/28,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB	**ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)**		• U_0=28,0/28,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
							ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-f	• сменные предохранители;	• U_0=28,0/28,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
							ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-P	• повышенная мощность;	• U_0=28,0/28,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
							ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-P-f	• повышенная мощность; • сменные предохранители;	• U_0=28,0/28,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
				ЭнИ-БИС-157-Ex-DC(+)-d	• в составе одного полюса диод;	• U_0=28,0/28,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB	**ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-d**	• в составе одного полюса диод;	• U_0=28,0/28,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
				ЭнИ-БИС-157-Ex-DC(+)-d-P	• в составе одного полюса диод; • повышенная мощность;	• U_0=28,0/28,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB	**ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-d-P**	• в составе одного полюса диод; • повышенная мощность;	• U_0=28,0/28,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
							ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-d-f	• в составе одного полюса диод; • сменные предохранители;	• U_0=28,0/28,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
							ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-d-P-f	• в составе одного полюса диод; • повышенная мощность; • сменные предохранители;	• U_0=28,0/28,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
				ЭнИ-БИС-158-Ex-DC(+)		• U_0=28,0 В; • [Ex ib Gb] IIC/IIB	**ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(+)**		• U_0=28,0 В; • [Ex ib Gb] IIC/IIB
							ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(+)-P	• повышенная мощность;	• U_0=28,0 В; • [Ex ib Gb] IIC/IIB
							ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(+)-PP	• повышенная мощность;	• U_0=28,0 В; • [Ex ib Gb] IIC/IIB
							ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(+)-f	• сменные предохранители;	• U_0=28,0 В; • [Ex ib Gb] IIC/IIB
							ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(+)-P-f	• повышенная мощность; • сменные предохранители;	• U_0=28,0 В; • [Ex ib Gb] IIC/IIB
Датчики с выходом «сухой контакт»	**ЭнИ-БИС-101-Ex**		• U_0=8,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB	**ЭнИ-БИС-154-Ex-DC(+)**		• U_0=21,0/21,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB	**ЭнИ-БИС-1154-Ex-DC(+)**		• U_0=21,0/21,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
	ЭнИ-БИС-102-Ex		• U_0=12,8 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB	**ЭнИ-БИС-157-Ex-DC(+)-d**	• в составе одного полюса диод;	• U_0=28,0/28,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB	**ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-d**	• в составе одного полюса диод;	• U_0=28,0/28,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
							ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-d-P	• в составе одного полюса диод; • повышенная мощность;	• U_0=28,0/28,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
							ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-d-f	• в составе одного полюса диод; • сменные предохранители;	• U_0=28,0/28,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
							ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-d-P-f	• в составе одного полюса диод; • повышенная мощность; • сменные предохранители;	• U_0=28,0/28,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
	ЭнИ-БИС-103-Ex		• U_0=6,5 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB						
	ЭнИ-БИС-104-Ex		• U_0=12,6 В; • [Ex ib Gb] IIC/IIB						
Термосопротивления (четырехпроводная схема)	**ЭнИ-БИС-106-Ex**	• диоды в составе одного канала;	• U_0=12,8 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB	**ЭнИ-БИС-155-Ex-AC**		• U_0=9,0/9,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB	**ЭнИ-БИС-1155-Ex-AC-P-s**	• повышенная мощность; • дополнительные стабилитроны между ветвями барьера;	• U_0=9,0/9,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
	ЭнИ-БИС-107-Ex		• U_0=12,8 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB				**ЭнИ-БИС-1007-Ex-DC(+)**		• U_0=13,5/13,5 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
	ЭнИ-БИС-108-Ex		• U_0=25,2 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB				**ЭнИ-БИС-1008-Ex-AC**		• U_0=25,8/25,8; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
							ЭнИ-БИС-1160-Ex-AC		• U_0=10,5/10,5 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
	ЭнИ-БИС-117-Ex		• U_0=27,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB						
Термосопротивления (трехпроводная схема)	**ЭнИ-БИС-109-Ex**		• U_0=9,3 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB				**ЭнИ-БИС-1009-Ex-AC**		• U_0=9,3 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
Термопары				**ЭнИ-БИС-155-Ex-AC**		• U_0=9,0/9,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB	**ЭнИ-БИС-1155-Ex-AC-P-s**	• повышенная мощность; • дополнительные стабилитроны между ветвями барьера;	• U_0=9,0/9,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
							ЭнИ-БИС-1160-Ex-AC		• U_0=10,5/10,5 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
Тензодатчики	**ЭнИ-БИС-107-Ex**		• U_0=12,8 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB				**ЭнИ-БИС-1007-Ex-DC(+)**		• U_0=13,0/10,3 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
				ЭнИ-БИС-150-Ex-AC		• U_0=13,0/13,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB	**ЭнИ-БИС-1150-Ex-AC-s**	• дополнительные стабилитроны между ветвями барьера;	• U_0=13,0/13,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
							ЭнИ-БИС-1155-Ex-AC		• U_0=13,0/13,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
							ЭнИ-БИС-1155-Ex-AC		• U_0=9,0/9,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
							ЭнИ-БИС-1155-Ex-AC-P	• повышенная мощность;	• U_0=9,0/9,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
				ЭнИ-БИС-155-Ex-AC		• U_0=9,0/9,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB	**ЭнИ-БИС-1155-Ex-AC-P-s**	• повышенная мощность; • дополнительные стабилитроны между ветвями барьера;	• U_0=9,0/9,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
							ЭнИ-БИС-1159-Ex-AC-P	• повышенная мощность;	• U_0=13,0/13,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
				ЭнИ-БИС-159-Ex-AC-P	• повышенная мощность;	• U_0=13,0/13,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB	**ЭнИ-БИС-1159-Ex-AC-P-s**	• повышенная мощность; • дополнительные стабилитроны между ветвями барьера;	• U_0=13,0/13,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
Электромагнитные клапана				**ЭнИ-БИС-158-Ex-DC(+)**		• U_0=28,0 В; • [Ex ib Gb] IIC/IIB	**ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(+)**		• U_0=28,0 В; • [Ex ib Gb] IIC/IIB
				ЭнИ-БИС-158-Ex-DC(–)			**ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(–)**		
							ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(–)-P	• повышенная мощность;	• U_0=28,0 В; • [Ex ib Gb] IIC/IIB
							ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(–)-P-f-	• повышенная мощность; • сменные предохранители;	• U_0=28,0 В; • [Ex ib Gb] IIC/IIB
				ЭнИ-БИС-157-Ex-DC(+)-d	• в составе одного полюса диод;	• U_0=28,0/28,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB	**ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-d**	• в составе одного полюса диод;	• U_0=28,0/28,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
				ЭнИ-БИС-157-Ex-DC(+)-d-P	• в составе одного полюса диод; • повышенная мощность;	• U_0=28,0/28,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB	**ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-d-P**	• в составе одного полюса диод; • повышенная мощность;	• U_0=28,0/28,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
							ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-d-f	• в составе одного полюса диод; • сменные предохранители;	• U_0=28,0/28,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
							ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-d-P-f	• в составе одного полюса диод; • повышенная мощность; • сменные предохранители;	• U_0=28,0/28,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
							ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(+)-P	• повышенная мощность;	• U_0=28,0 В; • [Ex ib Gb] IIC/IIB
							ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(+)-PP		
							ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(+)-f	• сменные предохранители;	• U_0=28,0 В; • [Ex ib Gb] IIC/IIB
							ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(+)-P-f	• повышенная мощность; • сменные предохранители;	• U_0=28,0 В; • [Ex ib Gb] IIC/IIB
Светодиодные индикаторы				**ЭнИ-БИС-157-Ex-DC(+)-d**	• в составе одного полюса диод;	• U_0=28,0/28,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB	**ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-d**	• в составе одного полюса диод;	• U_0=28,0/28,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
				ЭнИ-БИС-157-Ex-DC(+)-d-P	• в составе одного полюса диод; • повышенная мощность;	• U_0=28,0/28,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB	**ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-d-P**	• в составе одного полюса диод; • повышенная мощность;	• U_0=28,0/28,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
							ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-d-f	• в составе одного полюса диод; • сменные предохранители;	• U_0=28,0/28,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
							ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-d-P-f	• в составе одного полюса диод; • повышенная мощность; • сменные предохранители;	• U_0=28,0/28,0 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
				ЭнИ-БИС-158-Ex-DC(+)		• U_0=28,0 В; • [Ex ib Gb] IIC/IIB	**ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(+)**		• U_0=28,0 В; • [Ex ib Gb] IIC/IIB
				ЭнИ-БИС-158-Ex-DC(–)			**ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(–)**		
							ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(–)-P	• повышенная мощность;	• U_0=28,0 В; • [Ex ib Gb] IIC/IIB
							ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(–)-P-f	• повышенная мощность; • сменные предохранители;	• U_0=28,0 В; • [Ex ib Gb] IIC/IIB
							ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(+)-P	• повышенная мощность;	• U_0=28,0 В; • [Ex ib Gb] IIC/IIB
							ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(+)-PP		
							ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(+)-f	• сменные предохранители;	• U_0=28,0 В; • [Ex ib Gb] IIC/IIB
							ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(+)-P-f	• повышенная мощность; • сменные предохранители;	• U_0=28,0 В; • [Ex ib Gb] IIC/IIB
Вибродатчики				**ЭнИ-БИС-152-Ex-DC(–)**		• U_0=26,0/12,5 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB	**ЭнИ-БИС-1152-Ex-DC(–)**		• U_0=26,0 В /19,5 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB
Реостатный или потенциометрический датчик	**ЭнИ-БИС-105-Ex**		• U_0=12,6 В; • [Ex ia Ga] IIC/IIB						
Подключение устройств с максимальным током потребления до 50 мА	**ЭнИ-БИС-111-Ex**		• U_0=25,2 В; • [Ex ib Gb] IIC/IIB						
	ЭнИ-БИС-113-Ex	• 1 канал;	• U_0=24,0 В; • [Ex ib Gb] IIB						
	ЭнИ-БИС-118-Ex	• 1 канал;	• U_0=25,5 В; • [Ex ib Gb] IIB						
Интерфейс RS-485	**ЭнИ-БИС-113-Ex**	• 1 канал;	• U_0=5,7 В; • [Ex ib Gb] IIB				**ЭнИ-БИС-1013-Ex-DC(+)**	• 1 канал;	• U_0=8,0 В; • [Ex ib Gb] IIB
	ЭнИ-БИС-115-Ex	• 2 канала;	• U_0=8,0 В; • [Ex ib Gb] IIB				**ЭнИ-БИС-1015-Ex-DC(+)**	• 2 канала;	• U_0=8,0 В; • [Ex ib Gb] IIB
Интерфейс RS-422	**ЭнИ-БИС-115-Ex**	• 1 канал;	• U_0=8,0 В; • [Ex ib Gb] IIB				**ЭнИ-БИС-1015-Ex-DC(+)**	• 1 канал;	• U_0=8,0 В; • [Ex ib Gb] IIB
Интерфейс RS-232	**ЭнИ-БИС-116-Ex**	• 1 канал;	• U_0=12,5 В; • [Ex ib Gb] IIC/IIB				**ЭнИ-БИС-1016-Ex-AC**	• 1 канал;	• U_0=12,5 В; • [Ex ib Gb] IIB

Примечание: Пассивные барьеры можно применять для подключения другого оборудования, если технические характеристики удовлетворяют требованиям проекта.